

СВЕДЕНИЯ

о ведущей организации по диссертации Шевченко Алексея Ивановича на тему: «Влияние неидеальности решётки кремниевых и фуллеренсодержащих структур на их оптические и электрические свойства»

<p style="text-align: center;">Полное наименование организации</p>	<p style="text-align: center;">Сокращенное наименование организации</p>	<p style="text-align: center;">Место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»</p>	<p style="text-align: center;">Перечень основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15)</p>
<p>Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе» Российской академии наук</p>	<p>ФТИ им. А.Ф. Иоффе</p>	<p>Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 Тел.: (812) 297-2245 Адрес электронной почты: post@mail.ioffe.ru Сайт: www.ioffe.ru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аболмасов С.Н., Абрамов А.С., Иванов Г.А., Теруков Е.И., Емцев К.В., Няпшаев И.А., Базелей А.А., Губин С.П., Корнилов Д.Ю., Ткачев С.В., Ким В.П., Рындин Д.А., Левченкова В.И. Гетероструктурные солнечные элементы на основе монокристаллического кремния с контактной сеткой, напечатанной на принтере методом струйной печати // Письма в журнал технической физики. 2017. Т. 43, вып. 1. С. 74-79. 2. Шуман В.Б., Лаврентьев А.А., Астров Ю.А., Лодыгин А.Н., Порцель Л.М. Диффузия междузельного магния в бездислокационном кремнии // Физика и техника полупроводников. 2017. Т. 51, вып. 1. С. 5-7. 3. Зегря Г.Г., Савенков Г.Г., Морозов В.А., Зегря А.Г., Улин Н.В., Улин В.П., Лукин А.А., Брагин В.А., Оськин И.А., Михайлов Ю.М. Чувствительность к импульсным электрофизическим воздействиям энергонасыщенных соединений на основе высокодисперсного кремния и нанопористого кремния // Физика и техника полупроводников. 2017. Т. 51, вып. 4. С. 501-506.

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Березкин В.И., Попов В.В., Томкович М.В. Углеродный композит на основе фуллеренов и терморасширенного графита // Физика твердого тела. 2017. Т. 59, вып. 3. С. 601-609. 5. Dubrovskii V.G., Berdnikov Y., Olyanich D.A., Mararov V.V., Utas T.V., Zotov A.V., Saranin A.A. Scaling of size distributions of C₆₀ and C₇₀ fullerene surface islands // Applied Surface Science. 2017. Vol. 407. P. 117-120. 6. Белик В.П., Васютинский О.С., Кукин А.В., Петров М.А., Попов Р.С., Тербуков Е.И. Кристаллизация пленок аморфного гидрогенизированного кремния (a-Si:H) при облучении фемтосекундными лазерными импульсами // Письма в журнал технической физики. 2016. Т. 42, вып. 15. С. 36-42. 7. Кен О.С., Левицкий В.С., Явсин Д.А., Гуревич С.А., Давыдов В.Ю., Сресели О.М. Оптические и структурные свойства композитных слоев Si:Au, полученных лазерным электродиспергированием // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50, вып. 3. С. 423-430. 8. Емельянов А.М., Аболмасов С.Н., Тербуков Е.И. Фотолюминесценция в области края фундаментального поглощения текстурированного без маскирования монокристаллического кремния // Письма в журнал технической физики. 2016. Т. 42, вып. 19. С. 55-61. 9. Sachenko A.V., Kryuchenko Yu.V., Kostilyov V.P., Bobyl A.V., Terukov E.I., Abolmasov S.N., Abramov A.S., Andronikov D.A., Shvarts M.Z., Sokolovskyi I.O., Evstigneev M. Temperature dependence of photoconversion efficiency in silicon heterojunction solar
--	--	--	--

			<p>cells: Theory vs experiment // Journal of Applied Physics. 2016. Vol. 119. Art. no. 225702. 10 pp.</p> <p>10. Куницына Е.В., Гребенщикова Е.А., Коновалов Г.Г., Андреев И.А., Яковлев Ю.П. Повышение спектральной чувствительности фотодиодов для средней инфракрасной области спектра // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50, вып. 10. С. 1420-1424.</p> <p>11. Мынбаев К.Д., Заблоцкий С.В., Шилиев А.В., Баженов Н.Л., Якушев М.В., Марин Д.В., Варавин В.С., Дворецкий С.А. Дефекты в гетероэпитаксиальных структурах теллуридов кадмия и ртути, выращенных молекулярно-лучевой эпитаксией на подложках из кремния // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50, вып. 2. С. 208-211.</p> <p>12. Саченко А.В., Крюченко Ю.В., Костылев В.П., Соколовский И.О., Абрамов А.С., Бобыль А.В., Панайотти И.Е., Теруков Е.И. Метод оптимизации параметров гетеропереходных фотоэлектрических преобразователей на основе кристаллического кремния // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50, вып. 2. С. 259-263.</p> <p>13. Астрова Е.В., Ли Г.В., Румянцев А.М., Жданов В.В. Электрохимические характеристики наноструктурированных кремниевых анодов для литий-ионных аккумуляторов // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50, вып. 2. С. 279-286.</p> <p>14. Kuzmin M., Laukkanen P., Punkkinen M.P.J., Mäkelä J., Yasir M., Dahl J., Tuominen M., Kokko K. Sr/Si(100)(1 × 2) reconstruction as a template for the growth of crystalline high-<i>k</i> films on silicon: Atomic structure and</p>
--	--	--	---

			reactivity // Surface Science. 2016. Vol. 646. P. 140-145. 15. Kozlovski V.V., Lebedev A.A., Emtsev V.V., Oganessian G.A. Effect of the energy of recoil atoms on conductivity compensation in moderately doped n-Si and n-SiC under irradiation with MeV electrons and protons // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2016. Vol. 384. P. 100-105.
--	--	--	--

Председатель диссертационного совета Д 212.101.07



В.А. Бабешко

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.101.07

М.В. Зарецкая